

第9回九大2D物質研究会（グラフェン研究会改め）

主催：応用力学研究所

「2D物質の形成と物性」

平成29年1月27日（金） 13:00～17:00

於 九大筑紫キャンパス 応用力学研究所W601 号室

http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/map/map_fukuoka_city.pdf

1. 13:00～13:05

はじめに 九大院工 田中 悟

2. 13:05～13:35（30分）

島根大学院工 影島 博之 教授

「二次元物質の原子空孔の物性」

3. 13:35～14:05（30分）

関西学院大理工 日比野 浩樹 教授

「グラフェンのドメイン構造のLEEM 観察」

休憩 14:05～14:20

4. 14:20～14:50（30分）

NTT 物性科学基礎研究所 佐々木 健一 氏

「電荷ドーピングにより反転するカーボンナノチューブ光吸収の偏光依存性」

5. 14:50～15:20（30分）

九大院総理工 水野 清義 教授

「超高真空中におけるSiC(0001)上のSi₄O₅N₃層の作製」

休憩 15:20～15:35

6. 15:35～16:05（30分）

名古屋大院工 乗松 航 助教

「SiC上グラフェンの課題と界面制御」

7. 16:05～16:35（30分）

東大物性研 小森 文夫 教授

「SiCファセットに形成したナノリップルグラフェンの局所電子分光」

8. 16:35～17:00（25分）

九大院工 林 真吾（D2），田中 悟

「SiC(0001)上のSn 原子層の形成」

18:00～意見交換会

研究会に関するお尋ねは、エネルギー量子工学部門 田中 (stanaka@nucl.kyushu-u.ac.jp) まで

所内世話人：寒川義裕